

微電子學習題詳解

薛福隆 編譯

JACOB MILLMAN

MICRO- ELECTRONICS

Digital and Analog Circuits and Systems



全華科技圖書公司 印行

微電子學習題詳解

薛福隆 編譯

JACOB MILLMAN

MICRO- ELECTRONICS

Digital and Analog Circuits and Systems



全華科技圖書公司 印行



全華圖書 版權所有 翻印必究
局版台業字第0223號 法律顧問：陳培豪律師

微 電 子 學
(習題詳解)

薛福隆 編譯

出版者 全華科技圖書股份有限公司
北市龍江路76巷20-2號
電話：581-1300・541-5342
581-1382・581-1347
郵政帳號 1 0 0 8 3 6
發行人 陳 本 源
印刷者 華一彩色印刷廠
定 價 新臺幣 120 元
再 版 中華民國72年11月

感謝您

感謝您選購全華圖書！

希望本書能滿足您求知的慾望！

圖書之可貴在其量也在其質

量指圖書內容充實、質指資料新穎够水準，我們就是本著這個原則，竭心盡力地為國家科學中文化努力，貢獻給您這一本全是精華的全華圖書。

目 录

第一章	半導體.....	1
第二章	接面二極體.....	13
第三章	電晶體特性.....	31
第四章	積體電路：製作和特性.....	45
第五章	數位電路.....	51
第六章	組合數位系統.....	91
第七章	序列數位系統.....	105
第八章	場效電晶體.....	117
第九章	大型積體電路系統.....	131
第十章	類比二極體電路.....	145
第十一章	低頻放大器.....	167
第十二章	回授放大器.....	209
第十三章	放大器的頻率響應.....	233
第十四章	回授放大器頻率響應.....	263
第十五章	運算放大器.....	289
第十六章	運算放大器系統.....	319
第十七章	整形與波形產生器.....	347
第十八章	功率電路與系統.....	369

第一章 半導體

- 1-1 (a) 由(1-6)式加速電壓 $V_a = -V$

$$\frac{1}{2} m v_a^2 = \frac{1}{2} m v^2 - pV$$

今 $v_a = 0$ ，我們得知

$$V = mv^2 / 2q = \frac{9.11 \times 10^{-31} \times (1.88 \times 10^7)^2}{2 \times (1.60 \times 10^{-19})} = 1006 \text{ v}$$

- (b) 氬離子帶正電(1-6)式應為

$$\frac{1}{2} m' v^2 = \frac{1}{2} m' v_0^2 + qV$$

$$\begin{aligned} \text{由附錄 A, } m' &= 2.01 \times 1.66 \times 10^{-27} \\ &= 3.337 \times 10^{-27} \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{v_0^2 + \frac{2qV}{m'}} = \sqrt{10^{10} + \frac{2 \times 1.60 \times 10^{-19} \times 1006}{3.337 \times 10^{-27}}} \\ &= 3.27 \times 10^6 \text{ m/s} \end{aligned}$$

- 1-2 (a) 因 $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$ ，電子最初的能量

$$\text{爲 } 10^{-17} / 1.60 \times 10^{-19} = 62.5 \text{ eV}$$

由於減速電壓爲 -65 V ，電子無法抵達極板

(b) 62.5 V

1-3 (a) 令 $V_0 = 0$ ，由 (1-6) 式可得

$$\frac{1}{2} m v_x^2 = q V_0 \text{ 或 } v_x = \sqrt{\frac{2qV_0}{m}}$$

(b) 一旦電子進入 P_1, P_2 平板間的電場，它將以一定的加速度 a_y 向上加速

$$m a_y = q \epsilon_y = q \frac{V_p}{d}, \quad a_y = \frac{q V_p}{m d}$$

因此，當它離開 P_1, P_2 兩平板時 y 方向的速度爲

$$v_y = a_y t_p$$

在此 t_p 是電子通過平板所費的時間

$$t_p = \ell_0 / v_x$$

$$\text{由以上的式子, } v_y = \frac{q V_p \ell_0}{m d v_x}$$

(c) $d_0 = y_0 + y_1$ ，其中 y_0 是電子在平板內 y 方向的位移， y_1 是電子在離開 P_1, P_2 到抵達螢幕的時間 t_1 內在 y 方向的位移

$$d_0 = \frac{1}{2} a_y t_p^2 + v_y t_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{q V_p}{m d} \right) \left(\frac{\ell_0}{v_x} \right)^2 + \left(\frac{q V_p \ell_0}{m d v_x} \right) \left(\frac{\ell_0 - \ell_0/2}{v_x} \right)$$

$$d_0 = \frac{1}{v_x^2} \frac{q V_p}{m d} \left[\frac{1}{2} \ell_0^2 + \ell_0 (\ell_0 - \ell_0/2) \right] = \frac{1}{v_x^2} \frac{q V_p}{m d} \ell_0 \ell_0$$

把在(a)中所得的 v_x 代入，我們得到

$$d_0 = \frac{m}{2qV_0} \frac{qV_p}{m d} \ell_0 \ell_0 = \frac{1}{2} \frac{\ell_0 \ell_0}{d} \frac{V_p}{V_0}$$

$$(d) \quad v_x = \sqrt{\frac{2 \times 1.60 \times 10^{-19} \times 1000}{9.11 \times 10^{-31}}} = \sqrt{3.513 \times 10^{14}} = 1.874 \times 10^7 \text{ m/s}$$

$$v_y = \frac{q V_p \ell_0}{m d v_x} = \frac{1.60 \times 10^{-19} \times 100 \times 1.27 \times 10^{-2}}{9.11 \times 10^{-31} \times 0.5 \times 10^{-2} \times 1.874 \times 10^7} \\ = 2.38 \times 10^5 \text{ m/s}$$

$$d_0 = \frac{1}{2} \times \frac{1.27 \times 20}{0.5} \times \frac{100}{1000} = 2.54 \text{ cm}$$

(e) 由(c)知 V_0 與 d_0 成反比，因此

$$V_0 = \frac{2.54}{5} \times 1000 = 508 \text{ V}$$

1-4

(a) W_s 為電子在射極的總能量，故

$$W_s = \frac{1}{2} m v_0^2 + qV$$

$$= \frac{1}{2} 9.11 \times 10^{-31} \times 10^{12} + 0$$

$$= 4.555 \times 10^{-19} \text{ J} = \frac{4.555 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} \text{ eV} = 2.85 \text{ eV}$$

我們得到

$$\frac{x}{0.5} = \frac{2.85}{10} \text{ or } x = \frac{2.85}{10} \times 0.5 = 0.143 \text{ cm}$$

(b) 電子至少須有能量

$$W_e = 10 \text{ eV} = 10 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.6 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$W_e = \frac{1}{2} m v_s^2 + qV = \frac{1}{2} m v_s^2$$

$$v_s = \sqrt{\frac{2W_e}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.60 \times 10^{-18}}{9.11 \times 10^{-31}}} = 1.874 \times 10^5 \text{ m/s}$$

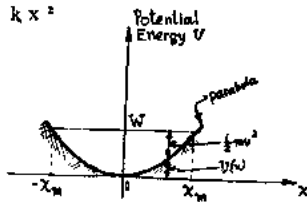
1-5 位能是 x 的函數，其關係式如下（見 FIG 2）

$$U(x) = - \int_0^x f(z) dz = \int_0^x k z dz = \frac{1}{2} k x^2$$

如果我們令 w 為總能量則如 FIG 2 所示

$$w = \frac{1}{2} m v^2 + U = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

$$\text{最大位移 } x_m \text{ 發生在 } v = 0 \text{ 時, } x_m = \sqrt{\frac{2w}{k}}$$



粒子將在 x_m 和 $-x_m$ 之間運動，其速度在 $x = 0$ 處為最大

1-6 (a) 位能 $U = mgy$

當 $v = 0$ 時粒子到達最大高度 y_m

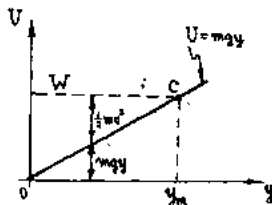
由 (1-5) 式

$$w = \text{constant} = \frac{1}{2} m v_0^2 = mgy_m$$

$$y_m = v_0^2 / 2g$$

(b) 由 FIG 3 很清楚地看出在折返點 C，

$v = 0$ 好像碰到一個位能障礙



- 1-7 按照定義，元素的原子重量等於它的原子量乘以單位原子重量，令一個原子的重量為 AM ，則

$$n = \left(\frac{\# \text{ atoms}}{AM} \right) \left(\nu \frac{\text{electrons}}{\text{atom}} \right) \left(d \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) = \frac{d \nu}{AM} \text{ electrons/m}^3$$

又由定義，分子量等於某種物質一莫耳的重量（以克為單位），因此若每個分子有 a_m 個原子，則

分子量為 $a_m A$ ，但

$$n = \left(\frac{1}{a_m A} \right) \left(\frac{\text{mole}}{\text{g}} \right) \left(10^3 \frac{\text{g}}{\text{kg}} \right) \left(A_o \frac{\text{molecules}}{\text{mole}} \right)$$

$$\left(a_m \frac{\text{atoms}}{\text{molecule}} \right) \left(d \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) \left(\nu \frac{\text{electrons}}{\text{atom}} \right)$$

$$n = \frac{10^3 A_o d \nu}{A} \text{ electrons/m}^3$$

- 1-8 電線的阻抗為

$$R = \rho \ell / A = \frac{3.44 \times 10^{-8} \times 0.5}{\pi \times (1 \times 10^{-3})^2} = 5.48 \times 10^{-6} \Omega$$

$$\text{再者 } V = RI = 5.48 \times 10^{-6} \times 30 \times 10^{-3} = 1.64 \times 10^{-4} \text{ V}$$

- 1-9 令電線的截面積為 A ，則

$$A = \pi r^2 = 3.14 \times (1.03 \times 10^{-3}/2)^2 = 8.33 \times 10^{-7} \text{ m}^2$$

$$(a) \quad I = JA = 2 \times 10^6 \times 8.33 \times 10^{-7} = 1.666 \text{ A}$$

$$(b) \quad v = J / nq = \frac{2 \times 10^6}{8.40 \times 10^{23} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 1.488 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

- (c) ϵ 為每單位長度的電壓降，即

$$\epsilon = 1 \text{ 公尺的電壓降}$$

$$= I \times (\text{每 1 公尺上的電阻})$$

$$= 1.666 \times 0.0214 = 0.0357 \text{ V/m}$$

$$\mu = v / \epsilon = 1.488 \times 10^{-4} / 0.0357 = 4.17 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{V}\cdot\text{s}$$

$$(d) \quad \sigma = nq\mu = 8.4 \times 10^{23} \times 1.60 \times 10^{-19} \times 4.17 \times 10^{-6} \\ = 5.61 \times 10^7 (\Omega\text{-m})^{-1}$$

- 1-10 (a) 一個質量 m 的电子以平均漂移速度 v 移動它的能量

$$w = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m (\mu_n \epsilon)^2$$

若 m 的單位是 kg ， μ 是 $\text{m}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ， ϵ 是 V/m ，則

$$w = \frac{\frac{1}{2} m \mu_0^2 \epsilon^2}{1.6 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} = \frac{m \mu_0^2 \epsilon^2}{3.2 \times 10^{-19}} = 1 \text{ eV}$$

用表 1-1 中的 μ_0 值

$$\epsilon = \left(\frac{3.2 \times 10^{-19}}{9.11 \times 10^{-31} \times (1300 \times 10^{-4})^2} \right)^{1/2} = 4.56 \times 10^5 \text{ V/m} \\ = 45.6 \text{ kV/cm}$$

(b) 因破壞一個矽的共價鍵需要能量 1.1 eV，所需的電壓為 45.6 kV/cm，我們可知以外加電壓來產生電子電洞對是不切實際的

$$1-11 \quad 1.23 \times 10^{23} \text{ electrons/cm}^3 = (6.02 \times 10^{23} \text{ atoms/mole}) \times \\ (1 \text{ mole} / 184 \text{ g}) \times (18.8 \text{ g/cm}^3) \times (\nu \text{ electrons/atom})$$

$$\nu = \frac{1.23}{6.02} \times \frac{184}{18.8} = 2$$

$$1-12 \quad (a) \quad n = 6.02 \times 10^{23} \frac{\text{atoms}}{\text{mole}} \times \frac{1 \text{ mole}}{63.54 \text{ g}} \times \frac{8.9 \text{ g}}{\text{cm}^3} \times \frac{10^6 \text{ cm}^3}{\text{m}^3} \times$$

$$1 \frac{\text{electron}}{\text{atom}} = 8.436 \times 10^{28} \text{ electrons/m}^3$$

$$\text{由式 (1-15)} \quad \sigma = nq\mu = 8.436 \times 10^{28} \times 1.60 \times 10^{-19} \times \\ 34.8 \times 10^{-4} = 4.697 \times 10^7 (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$

$$(b) \quad v_{drift} = \mu E = (34.8 \times 10^{-4}) (500) = 1.74 \text{ m/s}$$

$$1-13 \quad n = 6.02 \times 10^{23} \frac{\text{atoms}}{\text{mole}} \times \frac{1 \text{ mole}}{26.98 \text{ g}} \times \frac{3 \text{ electrons}}{\text{atom}} \times \frac{2.70 \text{ g}}{\text{cm}^3} \\ = 1.81 \times 10^{23} \frac{\text{electrons}}{\text{cm}^3}$$

1-14 (a) 依 (1-19)，(1-20) 兩式我們得

$$p^2 + (N_D - N_A)p - n_i^2 = 0$$

$$p = \frac{-(N_D - N_A) \pm \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}}{2}$$

取“+”號，因 $p > 0$

$$(N_D - N_A) \text{ 以 } (2-3) \times 10^{14} = -1 \times 10^{14} \text{ atoms/cm}^3 \text{ 代入}$$

$$\text{且 } n_i^2 = (2.5 \times 10^{13} \text{ atoms/cm}^3)^2$$

$$= 6.25 \times 10^{26} \text{ atoms}^2/\text{cm}^3, \text{ 我們得}$$

$$p = \frac{1 \times 10^{14} + \sqrt{10^{28} + 2.5 \times 10^{27}}}{2} + \frac{10^{14}}{2} + \frac{\sqrt{1.25 \times 10^{28}}}{2}$$

$$= 1.06 \times 10^{14} \text{ holes/cm}^3$$

由 (1-20) 式

$$\begin{aligned} n &= p + N_D - N_A = 1.06 \times 10^{14} - 1 \times 10^{14} \\ &= 0.06 \times 10^{14} = 6 \times 10^{12} \text{ electrons/cm}^3 \end{aligned}$$

因此這個樣品屬 p 型

- (b) 由 (1-20) 式和題目的條件 $N_D = N_A$ 可知 $n = p$

由 (1-19) 式

$$n = p = n_i = 2.5 \times 10^{13} \text{ electrons/cm}^3$$

仍可視為本質半導體

- (c) 在此 $N_A \ll N_D$, 可知 $n \gg p$ 由 (1-20) 式得到

$$n \approx N_D = 10^{16} \text{ electrons/cm}^3$$

$$\begin{aligned} \text{再由 (1-19) 式 } p &= n_i^2 / n = 6.25 \times 10^{28} / 10^{16} \\ &= 6.25 \times 10^{12} \text{ holes/cm}^3 \end{aligned}$$

很顯然, 這樣品是 n 型

- 1-15 (a) 在此 $p_f \gg n_f$ 且由 (1-26) 式

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = q(n_f \mu_n + p_f \mu_p)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho} &\approx q p_f \mu_p = \frac{1}{0.02 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1800} \\ &= 1.73 \times 10^{17} \text{ holes/cm}^3 \end{aligned}$$

再由 (1-19) 式

$$n_f = n_i^2 / p_f \approx 3.6 \times 10^8 \text{ electrons/cm}^3$$

- (b) 在此 $p_0 \ll n_0$, 由 (1-26) 式

$$\frac{1}{\rho} = q n_0 \mu_n$$

$$n_0 \approx \frac{1}{1.6 \times 10^{-19} \times 20 \times 1300} = 2.40 \times 10^{14} \text{ electrons/cm}^3$$

$$\begin{aligned} p_0 &= n_i^2 / n_0 = (1.5 \times 10^{10})^2 / 2.4 \times 10^{14} = 9.375 \times 10^5 \\ &\text{holes/cm}^3 \end{aligned}$$

- 1-16 (a) $n = p = n_i$ 由 (1-26) 式和表 1-1

$$\begin{aligned} \sigma &= q n_i (\mu_n + \mu_p) = 1.60 \times 10^{-19} \times 2.5 \times 10^{13} \times (3800 + \\ &1800) = \frac{2.24 \times 10^{-5}}{\Omega \cdot \text{cm}} \end{aligned}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = 44.64 \Omega \cdot \text{cm}$$

(b) 由表 1-1

$$n_{\text{Ge}} = 4.4 \times 10^{22} \text{ atoms/cm}^3$$

$$n \approx n_{\text{Ge}} / 10^8 = 4.4 \times 10^{14} \text{ atoms/cm}^3$$

$$p \approx n_i^2 / n \approx 6.25 \times 10^{22} / 4.4 \times 10^{14} = 1.42 \times 10^{12} \text{ holes/cm}^3$$

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q(\mu_p p + \mu_n n)} \\ &= \frac{1}{1.60 \times 10^{-19} (1800 \times 1.42 \times 10^{12} + 3800 \times 4.4 \times 10^{14})} \\ &= 3.73 \Omega \cdot \text{cm} \end{aligned}$$

1-17 (a) 同 1-16(a)題

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{qn_i(\mu_n + \mu_p)} = \frac{1}{1.60 \times 10^{-19} \times 1.5 \times 10^{16} \times (1300 + 500)} = 2.315 \Omega \cdot \text{cm}$$

(b) 假設加了施體之後 $N_D \approx n \gg p$ 則

$$\sigma = qn\mu_n$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{\sigma}{q\mu_n} = \frac{1}{\rho q\mu_n} \\ &= \frac{1}{9.6 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1300} = 5.0 \times 10^{14} / \text{cm}^3 \end{aligned}$$

由表 1-1 矽原子的密度為 $5.0 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ 故

$$\frac{5.0 \times 10^{14}}{5.0 \times 10^{22}} = \frac{1}{10^8}$$

$$1-18 \quad R = \rho \frac{\ell}{A}$$

$$\frac{d\sigma}{\sigma} = \frac{dn_i}{n_i} = d[\ell n n_i(T)] \quad (1)$$

$$\text{而 } n_i(T) = A_0^{\frac{1}{2}} T^{\frac{3}{2}} \exp(-E_{\text{Go}}/2kT) \quad (1-27) \text{ 式}$$

$$\text{故 } \ell n[n_i(T)] = \frac{1}{2} \ell n A_0 + \frac{3}{2} \ell n T - \frac{E_{\text{Go}}}{2kT} \quad (2)$$

$$\ell = 5 \text{ cm}, A = 2 \times 4 \text{ mm}^2 = 8 \times 10^{-2} \text{ cm}^2$$

$$\text{由 1-17 (a) 題, 知 } \rho = 2.315 \times 10^3 \Omega \cdot \text{cm}$$

$$\text{因此 } R = 2.315 \times 10^3 \times 5 / 8 \times 10^{-2} = 1.447 \times 10^7 \Omega$$

1-19 對本質半導體而言 $\sigma = q(\mu_p + \mu_n)n_i$

由(1)(2)兩式

$$\frac{d\sigma}{\sigma} = \frac{3dT}{2T} + \frac{E_{ao}dT}{2kT^2} = \left(\frac{3}{2} + \frac{E_{ao}}{2kT} \right) \frac{dT}{T}$$

$$\begin{aligned}\text{當 } T = 300^\circ\text{K} \quad kT &= (8.62 \times 10^{-5} \text{ eV}/^\circ\text{K}) 300^\circ\text{K} \\ &= 0.0259 \text{ eV}\end{aligned}$$

又由表 1-1 矽的 $E_{ao} = 1.21 \text{ eV}$ 因此

$$\frac{d\sigma}{\sigma} = \left(\frac{3}{2} + \frac{1.21}{0.0518} \right) \left(\frac{1}{300} \right) (100\%) = 8.286\% / ^\circ\text{K}$$

1-20 同 1-19 題矽的 $E_{ao} = 0.785 \text{ eV}$

$$\frac{d\sigma}{\sigma} = \left(\frac{3}{2} + \frac{0.785}{0.0518} \right) \left(\frac{1}{300} \right) (100\%) = 5.551\% / ^\circ\text{K}$$

1-21 決定 p , n 的關係式有

$$np = n_i^2 \quad (1-19) \text{ 和 } p + N_D = n + N_A$$

$$\text{今 } N_D = 1.874 \times 10^{13} / \text{cm}^3, \quad N_A = 3.748 \times 10^{13} / \text{cm}^3$$

$$\text{又 } n_i^2(T) = A_0 T^3 \exp(-E_{ao}/kT) \quad (1-27) \text{ 式}$$

由此

$$\begin{aligned}\frac{n_i^2(500\text{K})}{n_i^2(300\text{K})} &= \frac{500^3}{300^3} \exp \left[\left(-E_{ao}/k \right) \left(\frac{1}{500} - \frac{1}{300} \right) \right] \\ &= 4.630 \exp \left[\left(1.21/8.62 \times 10^{-5} \right) \times 0.00133 \right] \\ &= 4.630 \times 1.349 \times 10^3 = 6.246 \times 10^3\end{aligned}$$

$$\text{故 } n_i^2(500\text{K}) = 6.246 \times 10^3 \times (1.5 \times 10^{10})^2 = 1.405 \times 10^{23} / \text{cm}^3$$

由 (1-19), (1-20) 兩式

$$n[n + (N_A - N_D)] = n_i^2 \quad n^2 + (N_A - N_D)n - n_i^2 = 0$$

$$\begin{aligned}n &= \frac{-(N_A - N_D)}{2} + \frac{\sqrt{(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2}}{2} \\ &= \frac{-1.874 \times 10^{13}}{2} + \frac{\sqrt{(1.874 \times 10^{13})^2 + 4 \times 1.405 \times 10^{23}}}{2} \\ &= 3.656 \times 10^{14} / \text{cm}^3\end{aligned}$$

$$p = n_i^2/n = 1.405 \times 10^{23} / 3.656 \times 10^{14} = 3.843 \times 10^{14} / \text{cm}^3$$

$n \approx p$ 這樣其實際上是本質的因為 N_A 和 N_D 都比 $n_i = 3.748 \times 10^{13} / \text{cm}^3$ 小得多

1-22 想求 n , p 須先求得 n_i , 這可由 (1-26) 式中令 $n = p = n_i$ 而得

$$\begin{aligned}n_i &= \frac{\sigma}{q(\mu_n + \mu_p)} = \frac{1}{60 \times 1.6 \times 10^{-19} \times (3800 + 1800)} \\ &= 1.86 \times 10^{11} \text{ atoms/cm}^3\end{aligned}$$

同 1-21 題，由 (1-19) 式和 (1-20) 式

$$n = \frac{-(N_A - N_D)}{2} + \frac{\sqrt{(N_A - N_D)^2 + 4n_i^2}}{2} = \frac{3 \times 10^{15}}{2} + \frac{4.78 \times 10^{15}}{2}$$

$$= 3.89 \times 10^{15} \text{ electrons/cm}^3$$

$$p = n_i^2/n = (1.86 \times 10^{10})^2 / 3.89 \times 10^{15} = 8.89 \times 10^{14} \text{ holes/cm}^3$$

因此樣品的電導為

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p) = 1.6 \times 10^{-19} (3.89 \times 10^{15} \times 3800 + 8.89 \times 10^{14} \times 1800)$$

$$= 2.62 \times 10^{-2} / \Omega \cdot \text{cm}$$

最後，由 (1-14) 式我們得

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{J}{\sigma} = \frac{52.3 \text{ mA/cm}^2}{2.62 \times 10^{-2} / \Omega \cdot \text{cm}} \\ &= 1.996 \times 10^3 (\text{mA} \cdot \Omega) / \text{cm} = 1.996 \times 10^3 \text{ mV/cm} = 1.996 \text{ V/cm} \end{aligned}$$

1-23 (a) 依表 1-1

$$\text{密度} = 6.02 \times 10^{23} \frac{\text{atoms}}{\text{mole}} \times \frac{1 \text{ mole}}{72.6 \text{ g}} \times \frac{5.32 \text{ g}}{\text{cm}^3}$$

$$= 4.41 \times 10^{22} \text{ atoms/cm}^3$$

(b) 此時 $N_D = 4.41 \times 10^{22} \text{ atoms/cm}^3$

$$n = N_D$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(2.5 \times 10^{10})^2}{4.41 \times 10^{22}} = 1.42 \times 10^{12} \text{ holes/cm}^3$$

因 $n \neq p$,

$$\begin{aligned} \sigma &= nq\mu_n = 4.41 \times 10^{22} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 3800 \\ &= 0.268 (\Omega \cdot \text{cm})^{-1} \end{aligned}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = 3.72 \Omega \cdot \text{cm}$$

(c) 若每個原子提供金屬一個自由電子，則

$$n = 4.41 \times 10^{22} \text{ electrons/cm}^3 \text{ 且}$$

$$\sigma' = 4.41 \times 10^{22} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 3800 = 2.68 \times 10^7 (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$

$$\text{增加的比率 } \frac{\sigma'}{\sigma} = 10^9$$

1-24 本質的矽在 300 °K 時的電導 (由表 1-1)

$$\sigma_i = 2.3 \times 10^5 \frac{1}{\Omega \cdot \text{cm}} = 4.35 \times 10^{-6} (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$

若矽是一種共價金屬，每個原子將提供一個自由電子由表 1-1

$$n = 5.0 \times 10^{22} \text{ electrons/cm}^3$$

$$\sigma = qn\mu_n = 1.60 \times 10^{-19} \times 5.0 \times 10^{22} \times 1300 = 1.04 \times 10^7 \text{ (}\Omega \text{ - cm)}^{-1}$$

$$\frac{\sigma}{\sigma_i} = 2.39 \times 10^{12}$$

1-25 (a) $V_E = \frac{BJd}{\rho}$ 其中 $J = \sigma E_x$, $\rho = \frac{\sigma}{\mu}$

可得 $V_E = B E_x d \mu$, 因 $N_D \gg n_i = 1.5 \times 10^{10}$ (表 1-1)

所以矽棒是 n 型的, $\mu = \mu_n$

$$\begin{aligned} V_E &= 0.2 \times 500 \times 5 \times 10^{-3} \times 1300 \times 10^{-4} \\ &= 0.065 \text{ V} \end{aligned}$$

(b) 因 $N_A \gg n_i$ 在此 $\mu = \mu_p$

$$\begin{aligned} V_E &= 0.2 \times 500 \times 5 \times 10^{-3} \times 500 \times 10^{-4} \\ &= 0.025 \text{ V} \end{aligned}$$

1-26 $\mu_p = \frac{\sigma}{\rho}$ 在此 $\sigma = \frac{1}{200,000 \Omega \text{ - cm}} = 5 \times 10^{-6} \text{ (}\Omega \text{ - cm)}^{-1}$

由 (1-31) 式

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{BI}{V_E W} = \frac{0.1 \times 5 \times 10^{-6}}{30 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^{-3}} \\ &= 8.33 \times 10^{-4} \text{ C/m}^2 \\ &= 8.33 \times 10^{-9} \text{ C/cm}^2 \end{aligned}$$

$$\mu_p = \frac{5 \times 10^{-6}}{8.33 \times 10^{-9}} = 600 / \Omega \text{ - C} = 600 \text{ cm}^2/\text{V - s}$$

1-27 由 (1-32) 式

$$\rho = \frac{\sigma}{\mu_n} = \frac{10^{-3}}{1300 \times 10^{-4}} = 7.692 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$$

由 (1-31) 式

$$\begin{aligned} B &= \frac{V_E \rho W}{I} = \frac{40 \times 10^{-3} \times 7.692 \times 10^{-8} \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-6}} \\ &= 0.308 \text{ wb/m}^2 \end{aligned}$$

1-28 由本題的圖可知

$$p(x) = \begin{cases} \frac{p_0 - p(0)}{w} x + p(0) = hx + p(0), & 0 < x < w \\ p_0, & x > w \end{cases}$$

其中 $h = (p_0 - p(0)) / w < 0$

(a) 由 (1-33) 式 $J_{p0}(x) = -qD_p \frac{dp}{dx}$ ($\varepsilon = 0$)

$$J_{p0}(x) = \begin{cases} -qD_p h = J_0, & 0 < x < w \\ 0, & x > w \end{cases}$$

(b) 由 (1-36) 式 $J_v = q\mu_n p\varepsilon - qD_p \frac{dp}{dx} = 0$

$$\varepsilon = \frac{qD_p \frac{dp}{dx}}{q\mu_n p} = \frac{1}{p} \frac{D_p}{\mu_n} \frac{dp}{dx}$$

$$\varepsilon = \begin{cases} \frac{1}{p} \frac{D_p}{\mu_n} h, & 0 < x < w \\ \frac{1}{p} \frac{D_p}{\mu_n} 0 = 0, & x > w \end{cases}$$

以 $p(x) = hx + p(0)$ 和 V_T
 $= D_p / \mu_n$ 代入則得到

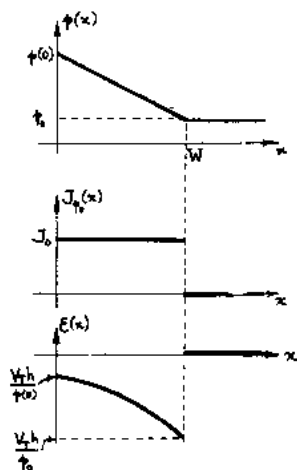
$$\varepsilon(x) = \begin{cases} \frac{V_T h}{hx + p(0)}, & 0 < x < w \\ 0, & x > w \end{cases}$$

$$(c) \quad v = - \int_{x=0}^w \varepsilon dx = - \int_0^w \frac{V_T h dx}{hx + p(0)}$$

$$= -V_T \ln(hx + p(0)) \Big|_0^w$$

$$= -V_T [\ln p_w - \ln p(0)] = -V_T \ln \frac{p_w}{p(0)} = -V_T \ln 10^{-3}$$

$$= 3V_T \ln 10 = 3 \times 25.9 \text{ mV} \times 2.302 = 178.9 \text{ mV}$$



1-29 (a) 總電子流為零，因此由 (1-37) 式

$$J_n = 0 = q\mu_n n\varepsilon + qD_n \frac{dn}{dx}$$

類似 (1-38) 式到 (1-41) 式

$$\varepsilon = -\frac{V_T}{n} \frac{dn}{dx}, \quad dV = V_T \frac{dn}{n}$$

$$V_{n1} = V_2 - V_1 = V_T \ln \frac{n_2}{n_1} = -V_T \ln \frac{n_1}{n_2}$$

$$n_1 = n_2 e^{-V_{n1}/V_T}$$

(b) 由於 $n_2 = n_n \approx N_D$

$$n_1 = n_n = n_i^2 / N_A$$

我們可知對步階 p-n 界面而言

$$V_o = V_T \ln \frac{n_p}{n_p} = V_T \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

1-30 (a) 由表 1-1 鎢原子的密度為 $4.4 \times 10^{22} / \text{cm}^3$

因此 $N_A = 4.4 \times 10^{22} / \text{cm}^3$

$N_D = 4.4 \times 10^{18} / \text{cm}^3$

(b) 由 (1-46) 式

$$V_o = V_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} = (0.0259) \ln \frac{4.4 \times 10^{22} \times 4.4 \times 10^{18}}{(2.5 \times 10^{10})^2}$$

$$= 0.0259 \times 10.34 = 0.268 \text{ V}$$

1-31 令 N_{D1} (V_{D1}) 為起初施體的濃度 (電壓差)

N_{D2} (V_{D2}) 為最後施體的濃度 (電壓差)

$$V_{o1} = V_T \ln \frac{N_A N_{D1}}{n_i^2}, \quad V_{o2} = V_T \ln \frac{N_A N_{D2}}{n_i^2}$$

$$V_{o2} - V_{o1} = V_T \ln \frac{N_A N_{D2}}{n_i^2} - V_T \ln \frac{N_A N_{D1}}{n_i^2} =$$

$$V_T \ln \frac{N_{D2}}{N_{D1}} = (0.0259 \text{ V}) \ln 10^4 = 0.0259 \times 9.21 = 0.239 \text{ V}$$

1-32 (a) $\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{N_A q \mu_p} = 2 \Omega \cdot \text{cm}$ $N_A = \frac{1}{2 \times 1.60 \times 10^{-19} \times 1800}$

$= 1.736 \times 10^{15} / \text{cm}^3$ 。同理

$$N_D = \frac{1}{1 \times 1.60 \times 10^{-19} \times 3800} = 1.645 \times 10^{15} / \text{cm}^3$$

由 (1-45) 式 $V_o = V_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$

$$0.026 \ln \frac{1.736 \times 10^{15} \times 1.645 \times 10^{15}}{(2.5 \times 10^{10})^2} = 0.026 \ln (4.569 \times 10^4) = 0.219 \text{ V}$$

(b) $N_A = \frac{1}{2 \times 1.60 \times 10^{-19} \times 500} = 6.25 \times 10^{15} / \text{cm}^3$

$$N_D = \frac{1}{1 \times 1.60 \times 10^{-19} \times 1300} = 4.81 \times 10^{15} / \text{cm}^3$$

$$\text{故 } V_o = 0.026 \ln \frac{6.25 \times 10^{15} \times 4.81 \times 10^{15}}{(1.5 \times 10^{10})^2} = 0.26 \ln (1.336 \times 10^{11}) = 0.666 \text{ V}$$